

ГЛОБА С.Н., канд. техн. наук, доцент, НТУ "ХПИ" (г. Харьков);
ДРОБИТЬКО А.И., магистр, НТУ "ХПИ" (г. Харьков)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КВАЗИСТАТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ СЛАБОМАГНИТНОГО ПЛОСКОГО ОБРАЗЦА

У роботі розглянуто методику і проведено відновлення квазістатичної кривої намагнічення слабомагнітного плоского зразка для загального випадку ($k \neq \text{const}$). Отримані основні співвідношення для розрахунку магнітного потоку, його фази, експериментальної та квазістатичної намагніченостей, методичної похибки.

The method of renewal in the quasistatistical curve of magnetizing of weak-magnetic flat sample in work considered and conducted for a general case ($k \neq \text{const}$). Basic correlations are got for the calculation of magnetic stream, his phase, experimental and quasistatistical of magnetizing, methodical error.

В качестве материалов применяемых при изготовлении элементов и узлов промышленных объектов широко используются наряду с ферромагнитными и слабомагнитные материалы (нержавеющая сталь, латунь и др.), которые представляет практический интерес в различных отраслях промышленности.

Известно, что магнитный контроль шихтованных и сплошных изделий и образцов рекомендуется проводить на постоянном токе [1, 2], но при этом требуется коммутация намагничивающего тока в питающей цепи преобразователя при контроле каждой точки кривой намагничивания либо петли гистерезиса, все это достаточно трудоемко, неудобно в эксплуатации, а, следовательно, затруднено в автоматизации процесса контроля магнитных характеристик и параметров. Контроль ферро- и слабомагнитных изделий и образцов целесообразно проводить в переменных магнитных полях, что позволяет автоматизировать процесс контроля. Исследуемые материалы используются в цепях переменного тока (в частности, в устройствах энергетического оборудования: трансформаторах, электродвигателях, реле, электромагнитах и др.), поэтому необходим контроль динамических магнитных характеристик и параметров. Но переменное магнитное поле затухает в сечении образца и приводит к неоднородному распределению напряженности и индукции внутри изделия, а также нелинейности магнитных характеристик.

Таким образом, если установить критерий слабого затухания магнитного поля в сечении образца и использовать методику восстановления квазистатических магнитных характеристик плоских слабомагнитных образцов по результатам контроля динамических характеристик тех же

образцов, то можно связать контроль магнитных характеристик и параметров в постоянных и переменных магнитных полях, что важно для теории и практики контроля. При этом возникает возможность рационального выбора толщин пластин энергетического оборудования и частот переменного магнитного поля.

Поскольку значения μ_r слабомагнитных материалов мало отличается от μ_r воздуха (или вакуума), то определяют не кривую индукции, а кривую намагниченности слабомагнитного образца.

Идея восстановления квазистатической кривой намагниченности слабомагнитного плоского образца состоит в том, что по результатам экспериментально полученной кривой намагниченности $J_s = f(H_0)$ на переменном токе конкретного слабомагнитного образца путем учета методической погрешности $\gamma_{\text{ин}}$ можно перейти к квазистатической зависимости $J_k = f(H_0)$, т.е. к зависимости, которую можно было бы получить на постоянном токе. Методическая погрешность $\gamma_{\text{ин}}$ (поправка) учитывает неоднородность магнитного поля внутри изделия и нелинейность кривой намагниченности.

Рассмотрим общий случай восстановления квазистатической кривой намагниченности слабомагнитного плоского образца ($k \neq \text{const}$), т.е. для всех участков кривой намагниченности. В работе [3] был рассмотрен частный случай ($k = \text{const}$), который соответствует начальному участку кривой намагниченности слабомагнитной пластины – слабое магнитное поле.

Следует отметить, что для испытаний использовался электромагнитный преобразователь с помещенным внутри его плоским образцом ($h/d \gg 1$ – плоский образец шириной h , толщиной d и длиной l). Преобразователь состоит из тонкого диэлектрического каркаса с нанесенными на него измерительной W_2 и намагничивающей W_1 обмотками. Чтобы магнитное поле было достаточно однородным внутри намагничивающей обмотки, необходимо выполнить условие $l_k \gg h_k$ (где l_k и h_k – длина намагничивающей обмотки и ширина каркаса преобразователя соответственно). С целью уменьшения воздействия размагничивающего фактора на результаты измерений выбирались размеры плоских слабомагнитных образцов такими, чтобы $l/h \geq 10$.

Формула для расчета намагниченности J материала [1, 2] имеет вид:

$$J = k \cdot H, \quad (1)$$

где k – относительная магнитная восприимчивость материала образца;
 H – напряженность магнитного поля.

Намагниченность J характеризует магнитную индукцию $B_{\text{вещ}}$ вещества, т.е. ту индукцию, которую создают магнитные моменты всех заряженных

частиц атомов вещества (материала). Магнитная индукция $B_{вещ}$ вещества определяется как:

$$B_{вещ} = \mu_0 \cdot J = \mu_0 \cdot kH, \quad (2)$$

где μ_0 – магнитная постоянная; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м.

Вносимый магнитный поток $\Phi_{вн}$ вычисляется как:

$$\Phi_{вн} = \int_S B_{вещ} dS = \int_S \mu_0 kH dS. \quad (3)$$

где dS – дифференциал площади поперечного сечения изделия (для плоского образца шириной h и толщиной d площадь $S = h \cdot d$).

Иначе выражение для вносимого магнитного потока можно записать [3]:

$$\dot{\Phi}_{вн} = \dot{\Phi}_0 - \dot{\Phi}_\Sigma = \dot{\Phi}_{20} + \dot{\Phi}_1 - \dot{\Phi} - \dot{\Phi}_1 = \dot{\Phi}_{20} - \dot{\Phi}, \quad (4)$$

где $\dot{\Phi}_\Sigma$ и $\dot{\Phi}_0$ – магнитные потоки в преобразователе при наличии образца и в его отсутствии; $\dot{\Phi}_1$ – магнитный поток в воздушном зазоре между изделием и измерительной обмоткой; $\dot{\Phi}_{20}$ – магнитный поток, пронизывающий сечение воздуха толщиной d ; $\dot{\Phi}$ – магнитный поток непосредственно в изделии

Если использовать символический метод с учетом выражения (4), тогда формулу для $\dot{\Phi}_{вн}$ запишем в виде:

$$\Phi_{вн} e^{j\omega t} e^{j\varphi_{вн}} = \Phi_{20} e^{j\omega t} - \Phi e^{j\omega t} e^{j\varphi}. \quad (5)$$

Причем магнитный поток в преобразователе без изделия Φ_{20} можно определить по формуле:

$$\Phi_{20} = 2\mu_0 H_0 h d. \quad (6)$$

Если в (5) воспользоваться формулой Эйлера, тогда модуль $\Phi_{вн}$ примет вид:

$$\Phi_{вн} = \sqrt{(\Phi_{20} - \Phi \cos \varphi)^2 + \Phi^2 \sin^2 \varphi}; \quad (7)$$

или после простых преобразований:

$$\Phi_{вн} = \sqrt{\Phi^2 + \Phi_{20}^2 - 2\Phi\Phi_{20} \cos \varphi}. \quad (8)$$

Исходя из соотношений (5) и (7), величина фазового угла $\varphi_{вн}$ сдвига между $\Phi_{вн}$ и Φ_{20} определяется как:

$$\operatorname{tg} \varphi_{вн} = -\frac{\Phi \sin \varphi}{\Phi_{20} - \Phi \cos \varphi}. \quad (9)$$

Считая угол φ достаточно малым, представим функции $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$ в виде разложения в ряды Тейлора:

$$\cos \varphi = 1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \dots; \quad (10)$$

$$\sin \varphi = \varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \dots. \quad (11)$$

Используя формулы (6), (8), (10) и результаты работ [3, 4] при условии $|\operatorname{tg} \varphi| \approx \varphi \approx \frac{1}{2} \frac{\mu_\delta}{\mu_r} X_d$ (причем обобщенный параметр $X_d = d/\delta$ был введен в [3, 4] для облегчения расчетов, где δ – глубина проникновения магнитного поля в образец), получим в общем случае выражение для амплитуды вносимого магнитного потока:

$$\Phi_{вн} = 2\mu_0 H_0 h d \sqrt{\left[\mu_r \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\mu_\delta}{\mu_r} X_d \right) - 1 \right]^2}. \quad (12)$$

Полученное выражение (12) после расчетов можно представить как:

$$\Phi_{вн} = 2\mu_0 H_0 h d (\mu_r - 1) \sqrt{1 - \left(\frac{\mu_\delta}{(\mu_r - 1)} X_d - \frac{1}{4} \frac{\mu_\delta^2}{(\mu_r - 1)^2} X_d^2 \right)}. \quad (13)$$

Выражение (13) с учетом малости второго слагаемого в круглых скобках под корнем по сравнению с единицей, представим в виде степенного ряда, ограничившись слагаемыми первого порядка, а именно:

$$\begin{aligned} \Phi_{вн} &= 2\mu_0 H_0 h d (\mu_r - 1) \left[1 - \left(\frac{\mu_\delta}{(\mu_r - 1)} X_d - \frac{1}{4} \frac{\mu_\delta^2}{(\mu_r - 1)^2} X_d^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \\ &= 2\mu_0 H_0 h d (\mu_r - 1) \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_\delta}{(\mu_r - 1)} X_d - \frac{1}{4} \frac{\mu_\delta^2}{(\mu_r - 1)^2} X_d^2 \right) \right] = \\ &= 2\mu_0 H_0 h d (\mu_r - 1) \left[1 - \left(\frac{1}{2} \frac{\mu_\delta}{(\mu_r - 1)} X_d - \frac{1}{8} \frac{\mu_\delta^2}{(\mu_r - 1)^2} X_d^2 \right) \right]. \end{aligned} \quad (14)$$

Если учесть связь [1] между относительной магнитной восприимчивостью k и относительной магнитной проницаемостью μ_r :

$$k = \mu_r - 1, \quad (15)$$

тогда намагниченность J материала образца рассчитывается как:

$$J = kH_0 = (\mu_r - 1)H_0, \quad (16)$$

Выражение для вычисления амплитуды вносимого магнитного потока $\Phi_{вн}$ с учетом (15) и (16) через магнитные восприимчивости имеет вид:

$$\Phi_{\text{вн}} = 2\mu_0 Jhd \left[1 - \left(\frac{1}{2} \frac{(k_\delta + 1)}{k} X_d - \frac{1}{8} \frac{(k_\delta + 1)^2}{k^2} X_d^2 \right) \right], \quad (17)$$

где k_δ – дифференциальная магнитная восприимчивость материала образца; $k_\delta = \mu_\delta - 1$.

Учитывая результаты работ [3, 4] и ограничиваясь слагаемыми порядка X_d^2 , т.к. $X_d = d/\delta \ll 1$ и $X_d^3 \ll 1$, запишем формулу для вычисления фазы $\Phi_{\text{вн}}$ магнитного потока в виде:

$$\Phi_{\text{вн}} = -\text{arctg} \left(\frac{1}{2} \mu_\delta X_d + \frac{1}{2} \mu_r \mu_\delta X_d - \frac{1}{4} \frac{\mu_\delta^2}{\mu_r} X_d^2 - \frac{1}{16} \mu_\delta^2 X_d^2 \right) \quad (18)$$

или через относительную и дифференциальную магнитные восприимчивости:

$$\Phi_{\text{вн}} = -\text{arctg} \left(\frac{1}{2} (k_\delta + 1) X_d + \frac{1}{2} (k + 1) (k_\delta + 1) X_d - \frac{1}{4} \frac{(k_\delta + 1)^2}{(k + 1)} X_d^2 - \frac{1}{16} (k_\delta + 1)^2 X_d^2 \right). \quad (19)$$

Используя выражение (14) с учетом

$$\Psi_{\text{вн}} = W_2 \Phi_{\text{вн}}, \quad (20)$$

где $\Psi_{\text{вн}}$ – вносимое потокосцепление,

найдем выражение для интегральной (экспериментально полученной) намагнитченности J_δ в виде:

$$J_\delta = \frac{\Psi_{\text{вн}}}{2W_2\mu_0hd} = J_\kappa \left[1 - \left(\frac{1}{2} \frac{\mu_\delta}{(\mu_r - 1)} X_d - \frac{1}{8} \frac{\mu_\delta^2}{(\mu_r - 1)^2} X_d^2 \right) \right] \quad (21)$$

или через магнитные восприимчивости как:

$$J_\delta = J_\kappa \left[1 - \left(\frac{1}{2} \frac{(k_\delta + 1)}{k} X_d - \frac{1}{8} \frac{(k_\delta + 1)^2}{k^2} X_d^2 \right) \right]. \quad (22)$$

С учетом малости второго слагаемого в квадратных скобках формулы (21) по сравнению с 1, получим выражение для вычисления квазистатической намагнитченности:

$$J_\kappa = J_\delta \left[1 + \left(\frac{1}{2} \frac{(k_\delta + 1)}{k} X_d - \frac{1}{8} \frac{(k_\delta + 1)^2}{k^2} X_d^2 \right) \right], \quad (23)$$

отсюда методическая погрешность $\gamma_{\text{ми}}$ определяется как:

$$\gamma_{\text{ми}} = \frac{1}{2} \frac{(k_\delta + 1)}{k} X_d - \frac{1}{8} \frac{(k_\delta + 1)^2}{k^2} X_d^2. \quad (24)$$

В общем случае, если задаться величиной допустимой погрешности $\gamma_{\text{мд}}$, тогда значение обобщенного параметра находят из условия (критерия) слабого затухания магнитного поля в слабомагнитном изделии

$$\gamma_{\text{ми}} = \frac{1}{2} \frac{(k_\delta + 1)}{k} X_d - \frac{1}{8} \frac{(k_\delta + 1)^2}{k^2} X_d^2 \leq \gamma_{\text{мд}}. \quad (25)$$

Отсюда, если ввести $\gamma_{\text{мд}}$, получим следующее квадратное уравнение

$$\frac{1}{8} \frac{(k_\delta + 1)^2}{k^2} X_d^2 - \frac{1}{2} \frac{(k_\delta + 1)}{k} X_d + \gamma_{\text{мд}} = 0, \quad (26)$$

решая которое, рассчитывается необходимый обобщенный параметр X_d .

Для упрощения расчета методической погрешности введем параметр Δ' , который определяется следующим образом:

$$\Delta' = \frac{1}{2} \frac{(k_\delta + 1)}{k}. \quad (27)$$

Используя экспериментальную зависимость $J_\delta = f(H_0)$, на практике вычисляют значение относительной магнитной восприимчивости $k(H_0)$ как:

$$k(H_0) = \frac{J_\delta}{H_0}, \quad (28)$$

где J_δ – экспериментальные значения намагнитченности, взятые для фиксированных рабочих точек H_0 кривой $J_\delta = f(H_0)$.

А значение дифференциальной магнитной восприимчивости $k_\delta(H_0)$ рассчитывают в виде:

$$k_\delta(H_0) = \frac{dJ_\delta}{dH_0} \approx \frac{J_{\delta i+1} - J_{\delta i}}{H_{0i+1} - H_{0i}}, \quad (29)$$

где $J_{\delta i+1}$ и $J_{\delta i}$ – последующее и предыдущее экспериментальные значения намагнитченностей, соответствующие каждому шагу изменения напряженности магнитного поля от H_{0i} до H_{0i+1} ;

H_{0i+1} и H_{0i} – последующее и предыдущее значение напряженности поля.

Таким образом, методика восстановления квазистатической кривой намагнитченности слабомагнитного плоского образца для общего случая ($k \neq const$) состоит в следующем:

1. По измеренной зависимости $J_\delta = f(H_0)$ рассчитывают значения $k(H_0)$ и $k_\delta(H_0)$ с помощью соотношений (28) и (29).

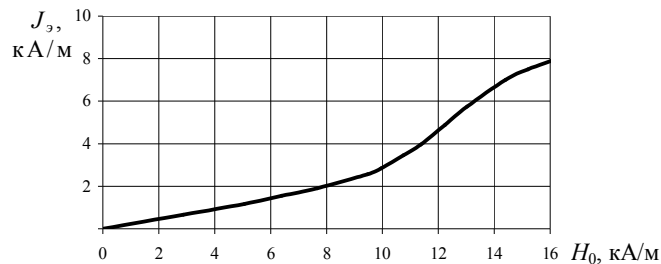


Рис. 1.

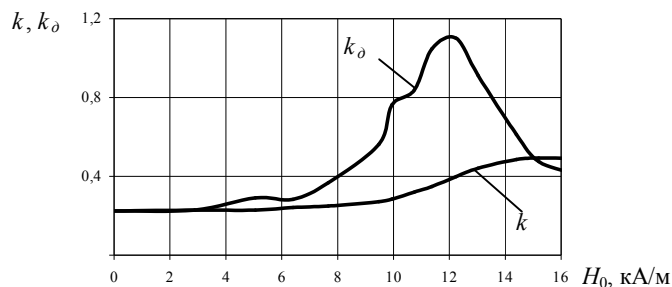


Рис. 2.

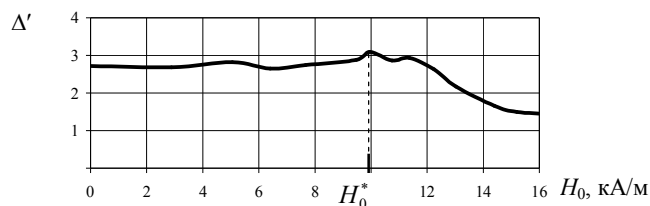


Рис. 3.

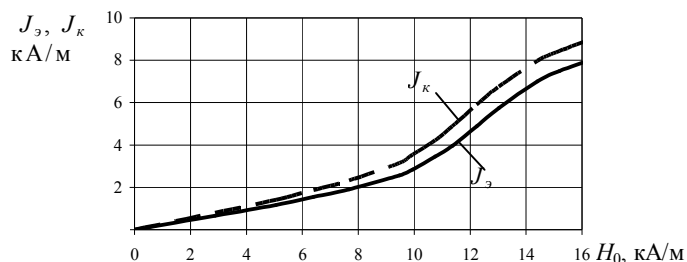


Рис. 4.

2. По формуле (24) находят методическую погрешность $\gamma_{ми}$ для каждой рабочей точки кривой намагниченности $J_з = f(H_0)$ при выбранном фиксированном значении обобщенного параметра X_d с заданной допустимой методической погрешностью $\gamma_{мд}$ согласно критерия (25). Обобщенный параметр X_d определяют из решения уравнения (26).

3. Используя (23) проводят восстановление квазистатической кривой намагниченности $J_к = f(H_0)$ на основании экспериментально полученной динамической кривой $J_з = f(H_0)$ для слабомагнитного плоского образца.

На рис.1 показана экспериментальная кривая намагниченности $J_з = f(H_0)$ слабомагнитного плоского образца № 1, полученная на феррометрической установке с использованием рабочего и компенсационного преобразователей. Рис.2 демонстрирует поведение относительной k и дифференциальной $k_д$ восприимчивостей в зависимости от H_0 . На рис.3 представлен график зависимости $\Delta' = f(H_0)$, здесь же показано максимальное значение $\Delta'_{max} = 3,09$ при $H_0^* = 9,95$ кА/м. На рис.4 приведены экспериментальная кривая намагниченности и восстановленная по методике квазистатическая зависимость $J_к = f(H_0)$ при допустимой методической погрешности $\gamma_{мд} = 0,25$.

Параметры слабомагнитного образца № 1: материал – нержавеющая сталь типа X18H10T; $d = 0,35 \cdot 10^{-3}$ м; $h = 7 \cdot 10^{-3}$ м; $l = 160 \cdot 10^{-3}$ м; $\sigma = 0,135 \cdot 10^7$ См/м; $k(H_0^*) = 0,285$; $k_д(H_0^*) = 0,763$. Испытания проводились при частоте $f = 1000$ Гц. Напряженность H_0^* соответствует значению $\Delta' = \Delta'_{max}$.

Таким образом, в работе проведено теоретическое и практическое восстановление квазистатической кривой намагниченности слабомагнитного плоского образца, выполненного из материала – нержавеющая сталь типа X18H10T, на основании магнитных испытаний в переменном магнитном поле.

Список литературы: 1. Кифер И.И. Испытания ферромагнитных материалов. – М.: Энергия, 1969. – 360 с. 2. Испытание магнитных материалов и систем / Под ред. А.Я. Шихина. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 376 с. 3. Себко В.П., Игнатъева С.Н. Определение квазистатической кривой намагничивания слабомагнитных материалов // Сборник научных трудов ХГПУ "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье". – Вып. 6. – Ч. 2. – Харьков: ХГПУ. – 1998. – С. 292-294. 4. Себко В.П., Игнатъева С.Н. Восстановление квазистатических кривых намагничивания // Український метрологічний журнал. – Харків: ДНВО "Метрологія". – 1998. – Вип. 3. – С. 28-31.